



國立交通大學

*National Chiao Tung University*

出國報告（出國類別： A類、考察、訪問）

赴美國 UC Berkeley 研究交流及出席  
IEDM 國際會議

服務機關：交通大學國際半導體產業學院

姓名職稱：張翼 院長

派赴國家：美國

出國期間：2016/12/02~2016/12/08

報告日期：2016/12/22

## 摘要

此次訪美為拜訪 UC Berkeley 胡正明教授，邀請其任聘為交大榮譽教授，由於胡教授先前已與本校 IRICE 計畫有廣泛合作，在 InGaAs FINFET 方面已有多方面接觸，因此在此領域，胡教授希望能持續合作。

## 目次

一、目的.....	1
二、過程.....	1
三、心得及建議.....	1
四、附錄.....	2

# 本文

## 一、目的

此次至美國主要是與美國 UC Berkeley 胡教授討論合作，並邀請其接受本校之榮譽教授教職。

## 二、過程

此次訪美為拜訪 UC Berkeley 胡正明教授，邀請其任聘為交大榮譽教授，由於胡教授先前已與本校 IRICE 計畫有廣泛合作，在 InGaAs FINFET 方面已有多方面接觸，因此在此領域，胡教授希望能持續合作，同時雙方並對最近合作之 E-Mode GaN 元件做詳細討論。最後胡教授同意接受本校之榮譽教授教職，任期將自明年開始。

此行之另一任務為替交大國際半導體學院與美國一流大學建立半導體學院之雙學位、交換學生等計畫。此行亦參加美國 IEEE 之 IEDM 之大會，此大會為每年 IEEE 電子元件之最大會議，在此大會中可與來自美國各大學之半導體專家，為建立合作之最佳地點，在此次大會中 Purdue 之 Peter Yeh、Notre Dame 之 Datta Suman、MIT 之 Alamo 及 UCLA 之 Jason Wu 等專家達成協議，成立交換學生計畫及計畫合作，並與台積電之國際校園合作負責人及技術長有初步協商，返國後將正式提出國際學生交換合作計畫。

另在本次 IEDM 會議中亦與 Lund university 之 panasonic 做 InGaAs FINFET 及 GaN HEMT on GaN substrate 元件之交換，此二篇 paper 為相關領域中之佼佼者，但本校在此方面之研究基礎堅強，應有機會迎頭趕上。

## 三、心得及建議

在本次的參訪當中，收集了許多寶貴經驗且很榮幸胡教授同意接受本校之榮譽教授教職，任期將自明年開始。且未來合作中可以鼓勵本校研究人員及學生至 UC Berkeley 進行移地研究，相信對於本校在發展先進半導體的進程上，必能有助益。

#### 四、附錄

無